



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102642838 B

(45) 授权公告日 2014. 10. 15

(21) 申请号 201210131483. X

(22) 申请日 2012. 04. 28

(73) 专利权人 中国科学院福建物质结构研究所  
地址 350002 福建省福州市杨桥西路 155 号

(72) 发明人 吕佩文 黄丰 董建平 林璋  
陈伦泰 颜峰坡

(51) Int. Cl.

C01B 33/037(2006. 01)

(56) 对比文件

JP 2010070425 A, 2010. 04. 02, 参见说明书第 43-54 段, 图 1-2.

WO 2011037473 A1, 2011. 03. 31, 参见说明书第 1 页最后 1 段至第 4 页最后 1 段, 表 1-3.

CN 101555013 A, 2009. 10. 14, 参见说明书全文.

CN 102040219 A, 2011. 05. 04, 参见说明书全文.

JP 2010195635 A, 2010. 09. 09, 参见说明书全文.

AU 2007298104 A1, 2009. 05. 21, 参见说明书全文.

CN 101085678 A, 2007. 12. 12, 参见说明书全文.

CN 102369158 A, 2012. 03. 07, 参见说明书全文.

审查员 吴莹莹

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

采用火法冶金与湿法冶金连用技术提纯高纯硅材料的方法

(57) 摘要

本发明涉及利用火法冶金与湿法冶金连用技术提纯硅材料的方法。火法冶金的过程中进行湿法冶金, 无需对工业硅进行破碎。本发明省去传统工艺中的凝固、破碎、粉碎、酸洗等多重步骤, 可以一次工艺流程中完成提纯工作。本发明对去除工业硅中的主要杂质包括 B、P、金属等具有很好的效果, 具有设备与工艺简单, 提纯效果好的优点。并且其工艺能耗低、成本低、产品收率高, 具有较好的推广价值。

